

2SK56 (保守品種/MAINTENANCE)

シリコン N チャンネル接合型 FET/Si N-Channel Junction FET

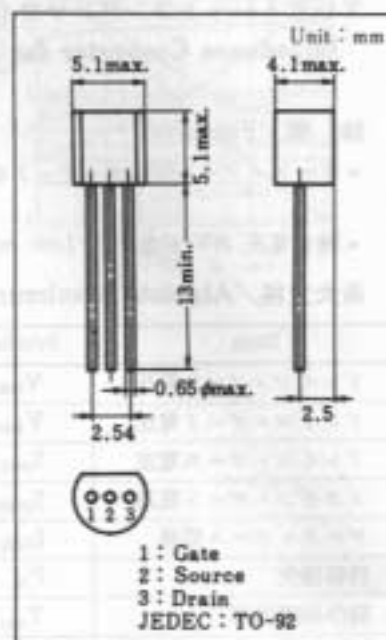
高周波増幅用/RF Amplifier

特 徴/Features

- 帰還容量 C_{rss} が小さい。/Low feedback Capacitance (C_{rss})
- 低雑音 $NF=4.5\text{dB (max.)}$ /Low noise figure $NF=4.5\text{dB (max.)}$

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSO}	10	V
ドレイン・ゲート電圧	V_{DGO}	10	V
ドレイン・ソース電流	I_{DSO}	10	mA
ドレイン・ゲート電流	I_{DGO}	10	mA
許容損失	P_D	100	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS}=1\text{V}, V_{DS}=0$			50	nA
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS}=5\text{V}, V_{GS}=0$	0.5		6	mA
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS}=5\text{V}, I_D=10\mu\text{A}$			2.5	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS}=5\text{V}, V_{GS}=0, f=1\text{kHz}$	1.9	4		mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=5\text{V}, V_{GS}=0, f=1\text{kHz}$		4		pF
出力容量	C_{oss}			3		pF
帰還容量	C_{rss}			0.7	0.15	pF
雑音指数	NF	$V_{DS}=5\text{V}, I_{DS}=1\text{mA}, f=100\text{MHz}$			4.5	dB
電力利得	PG	BW=1MHz	12			dB

* I_{DSS} ランク分類/ I_{DSS} Classifications

I_{DSS} (mA)	0.5~1.5	1.0~3.0	2.0~6.0
分 類	P	Q	R